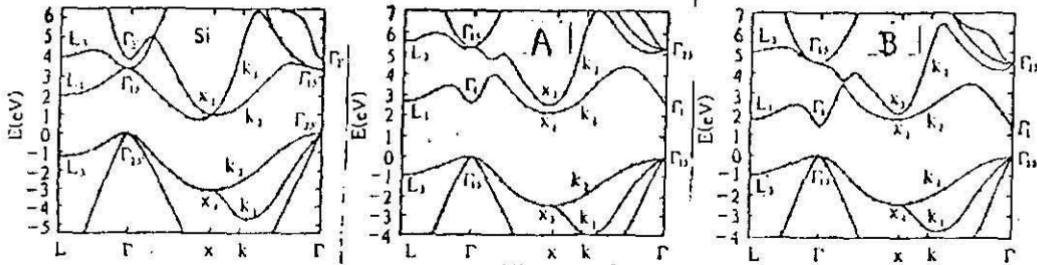




试题名称：

半导体物理



1. 上图是 (a)Si (b) 半导体 A (c) 半导体 B 的能带结构图 (E - k 图).

由图, 对这三种半导体分别回答:

- (1) 价带顶和导带底在 k 空间(或第一布里渊区)中的位置
- (2) 是直接带隙半导体还是间接带隙半导体
- (3) 能隙大约是多少?

(15 分)

2. 锗价带简并, 其价带顶附近电子能量表达式为

$$E_{1,2}(k)=E_0\left[1+\left(\frac{\hbar^2}{8\pi^2m_0}\right)\left\{A^2\pm\sqrt{A^4+C^2\left(k_x^2+k_y^2+k_z^2+\frac{2}{k_B T}\right)}\right\}\right]^{1/2}$$